

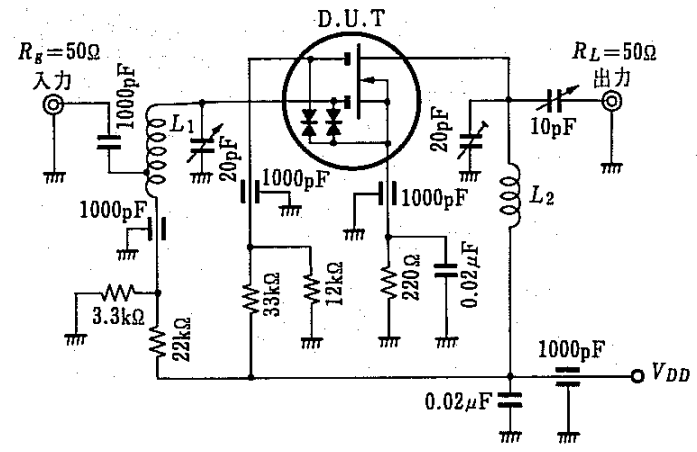
# 3SK59

## Si MOS 型 複合Nチャンネル

東 芝

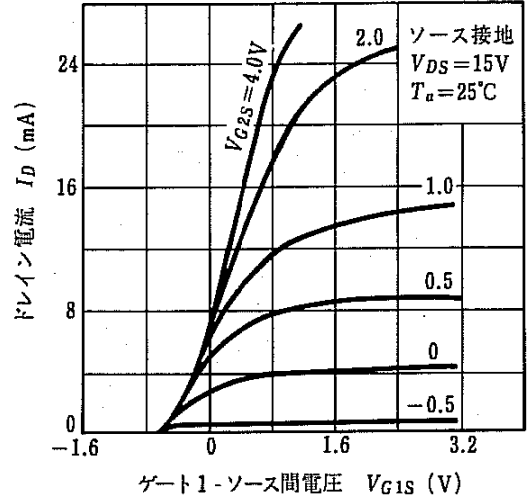
$I_{DSS}$  分類 Y: 3~7, GR: 6~14, BL: 12~24

100MHz 電力利得および雑音指数測定回路

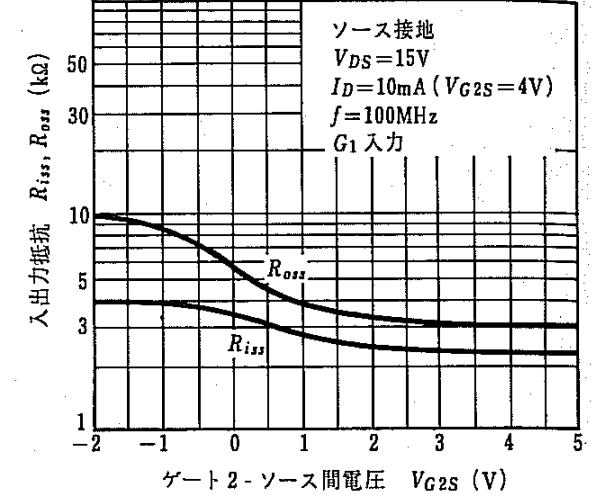


L1: φ1.0mm 銀メッキ銅線, 6.0T, 内径φ8mm, タップはアースから1.5Tの所  
L2: φ1.0mm 銀メッキ銅線, 4.0T, 内径φ8mm, 長さ10mm

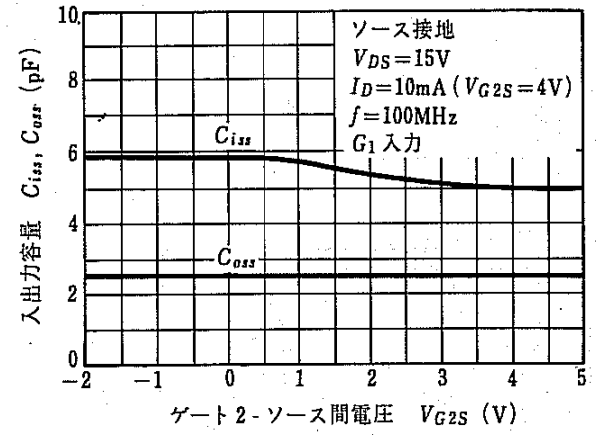
$I_D - V_{G1S}$  特性



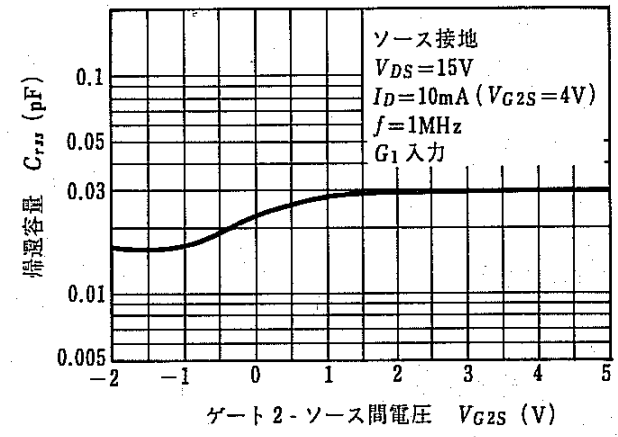
$R_{iss}, R_{oss} - V_{G2S}$  特性



$C_{iss}, C_{oss} - V_{G2S}$  特性



$C_{rss} - V_{G2S}$  特性



$G_{ps}, NF - V_{AGC} (V_{G2S})$  特性

